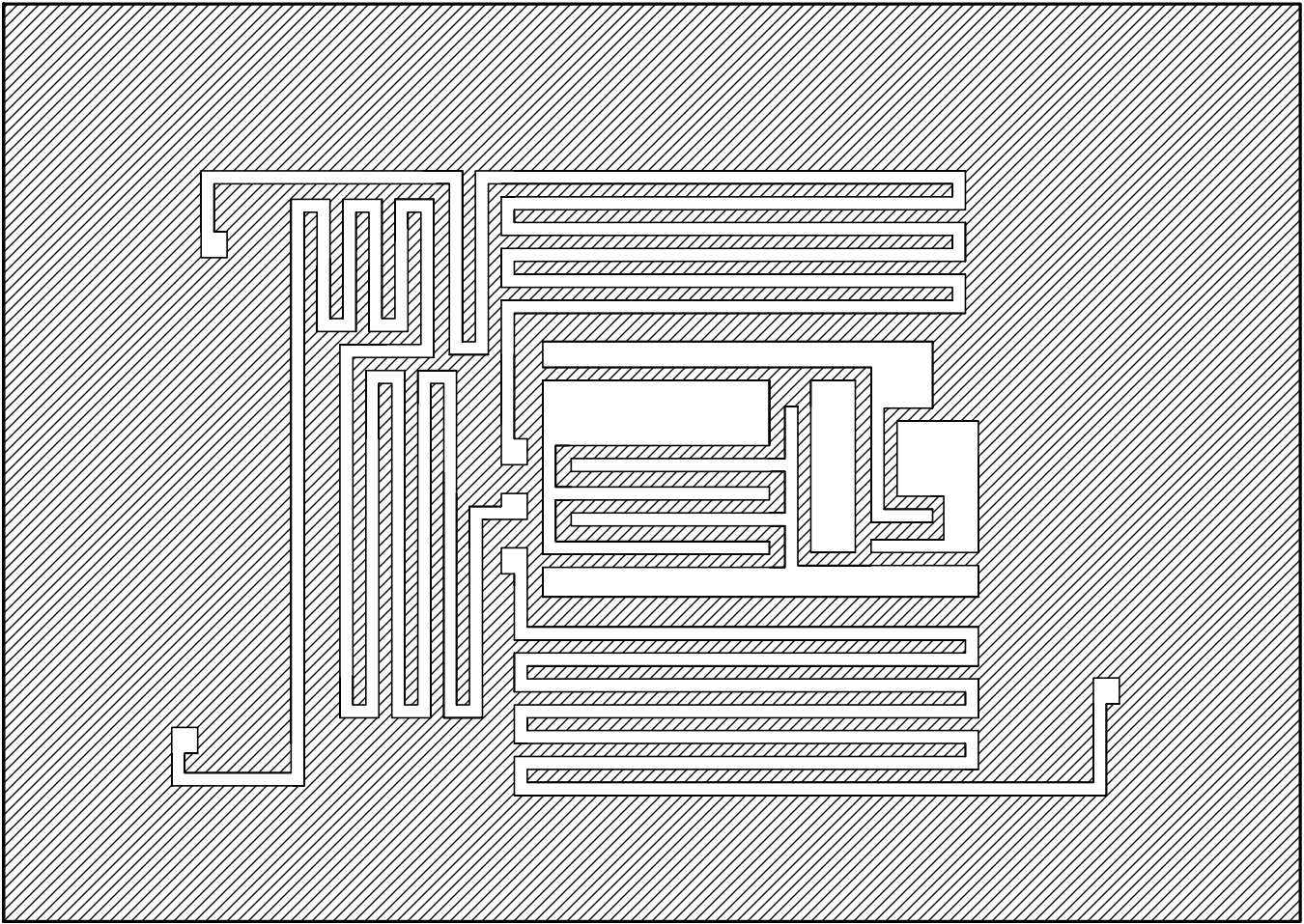
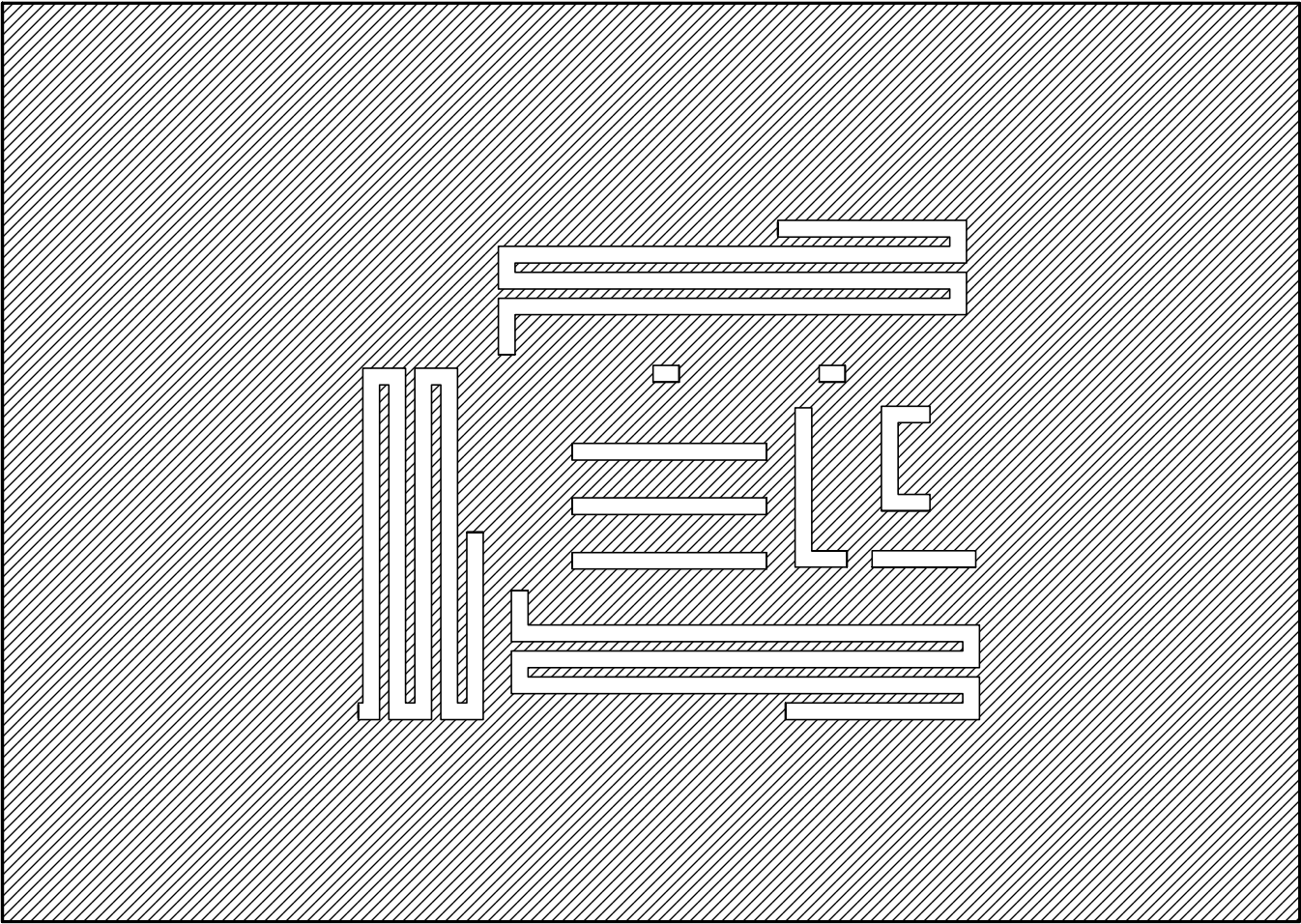


№	Шар	Матеріал	Товщина, мкм
1	Підкладка	КЕФ-3	120
2	Товстий діелектрик	SiO ₂	1,0
3	Дифузійні області	p ⁺ -Si	1,0
4	Область підлегування	n	0,5
5	Підзатворний діелектрик	SiO ₂	0,05
6	Металізація	Al	1,2
7	Пасивація	ФСС	1,0

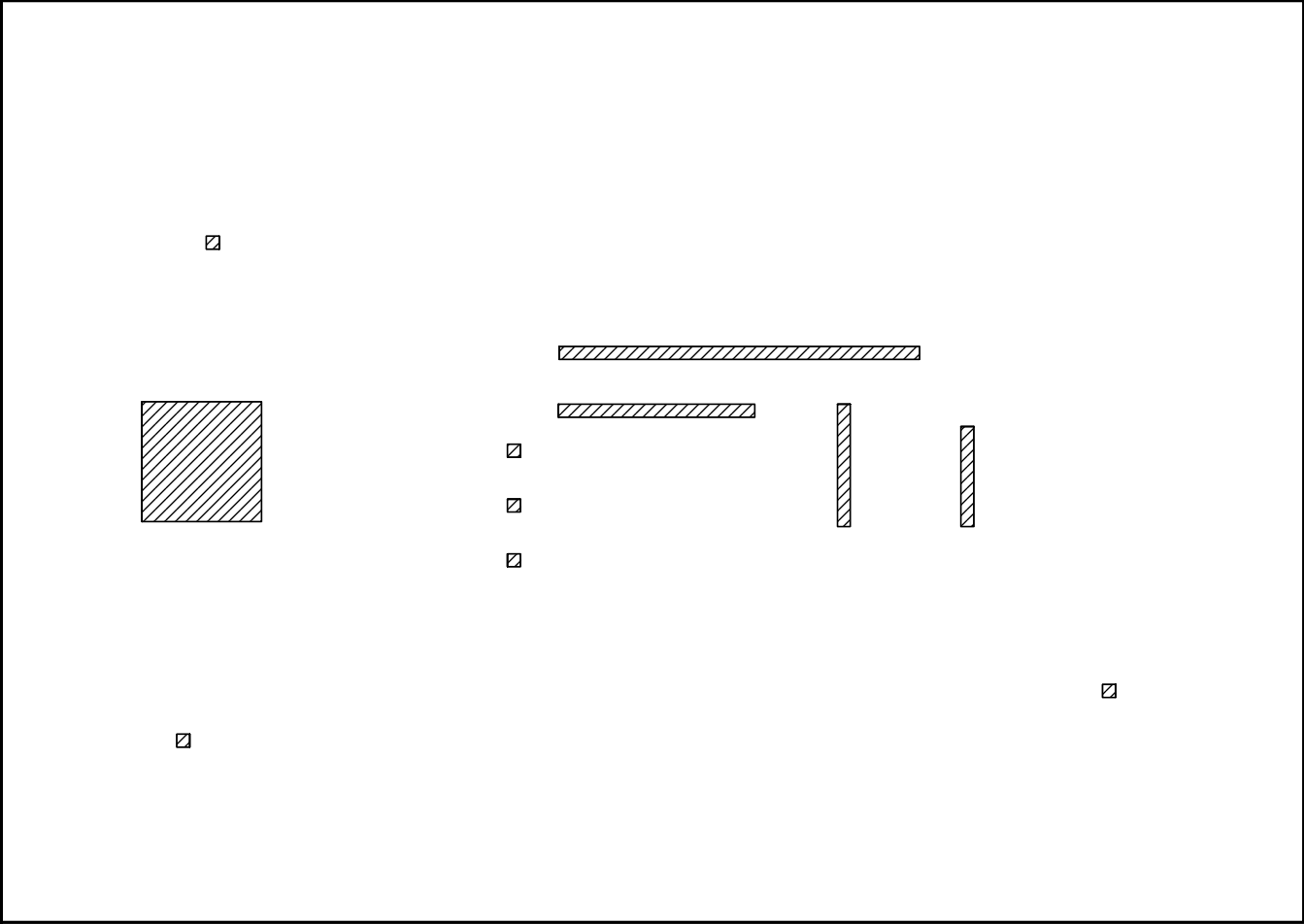
ДП82.8211.022.001.ТК					
Зм.	Лит.	№ докум.	Підпис	Дата	Топологічне креслення
Розроб.	Лищенко	Королевич			
Перевір.	Королевич				
Т.конт.					
Н.конт.					Аркуш 1 Архів 2
Затверд.					
					Лит. Маса Масштаб
					К 800:1
					НТУУ "КПІ", кафедра мікроелектроніки



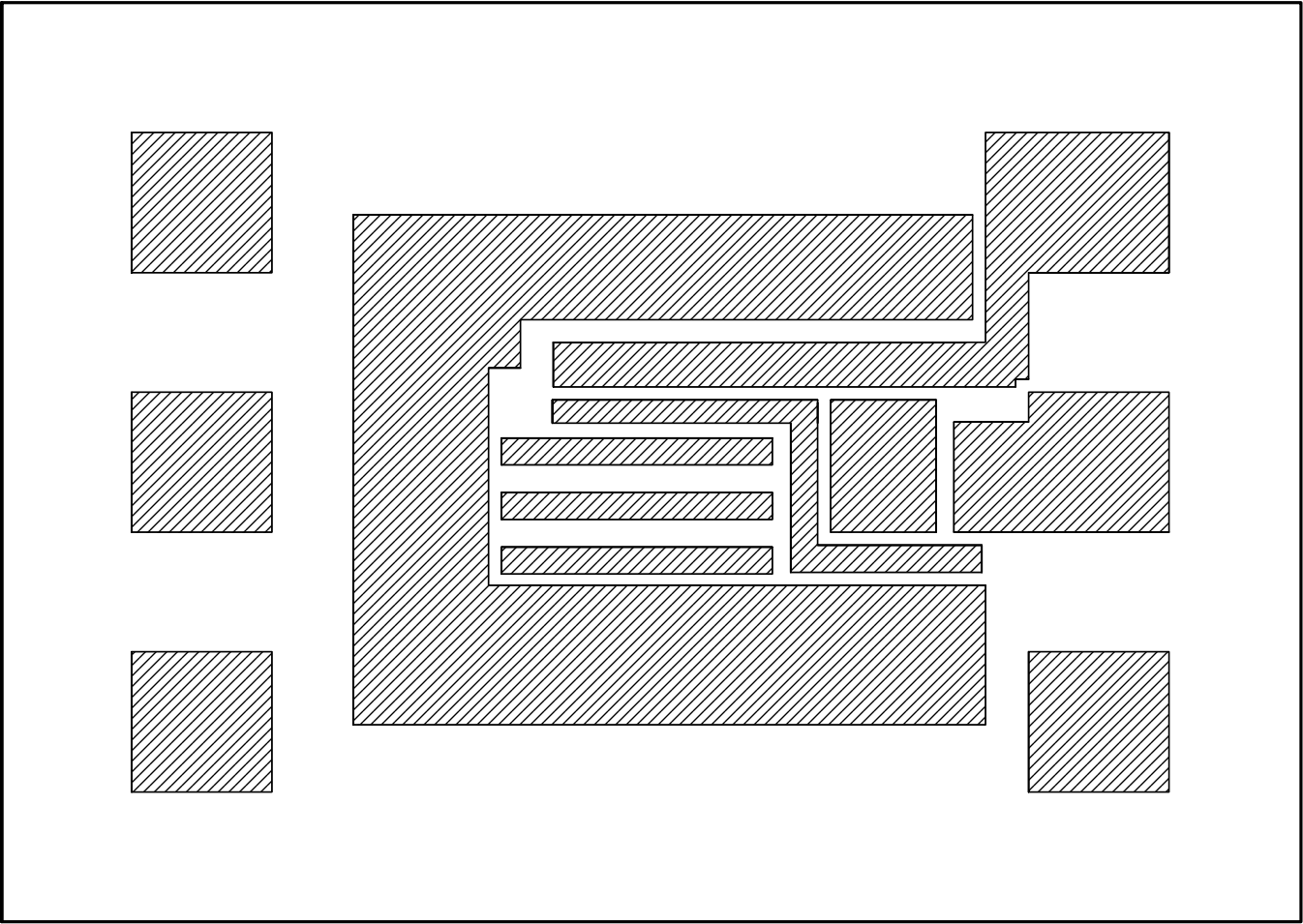
					ДП82.8211.022.001.ФШ			
					Фотошаблон	Літ.	Маса	Масштаб
Зм.	Літ.	№ докум.	Підпис	Дата		К		500:1
Розроб.		Лищенко						
Перевір.		Королевич						
Т.конт.						Аркуш	1	Аркушів
								5
Н.конт.					фотолітографія №1	НТУУ "КПІ", кафедра мікроелектроніки		
Затверд.								



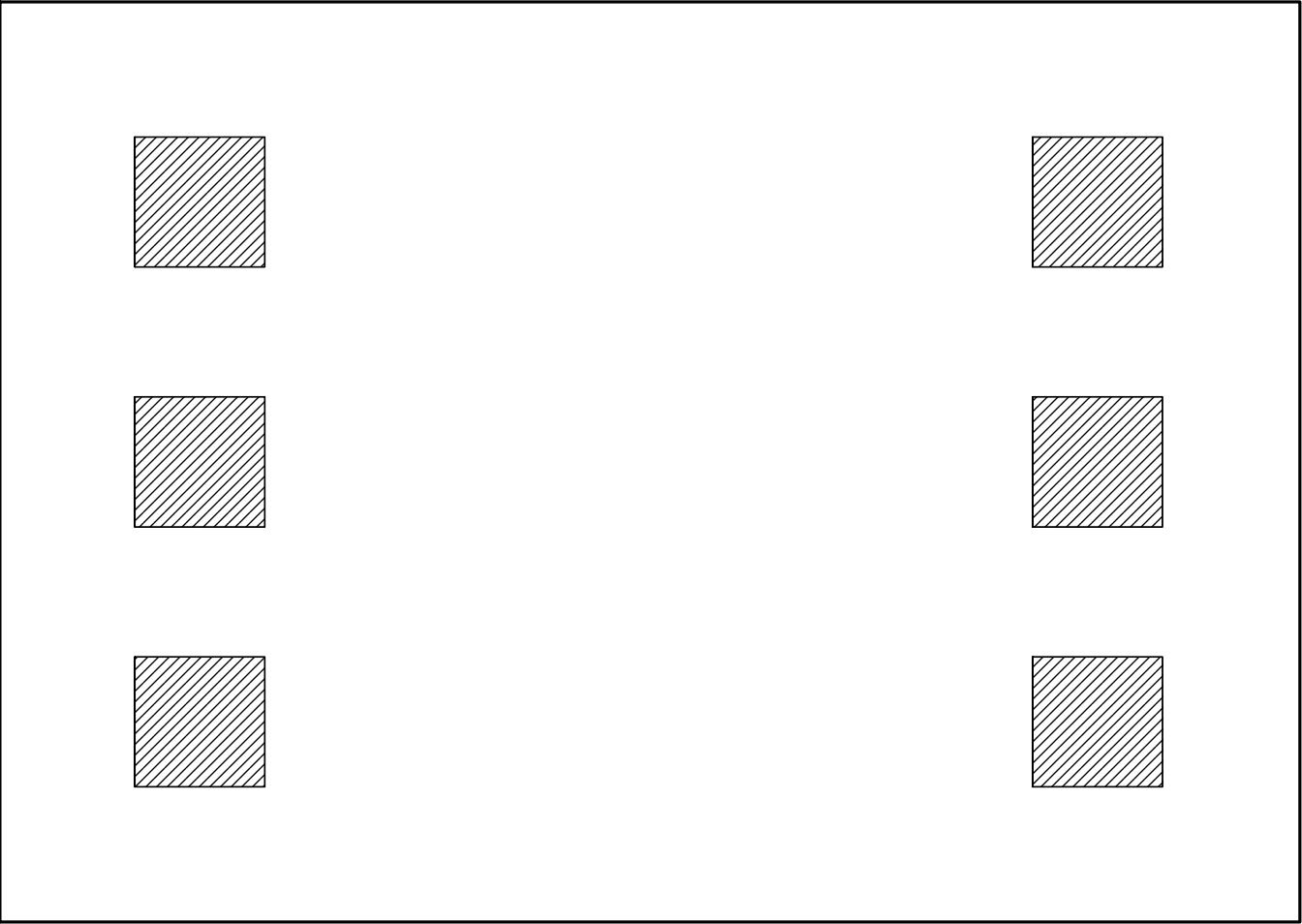
					ДП82.8211.022.001.ФШ						
					Фотошаблон	Літ.		Маса		Масштаб	
Зм.	Літ.	№ докум.	Підпис	Дата		К				500:1	
Розроб.		Лищенко									
Перевір.		Королевич									
Т.конт.											
					фотолітографія №2	Аркуш		2	Аркушів		5
Н.конт.						НТУУ "КПІ", кафедра мікроелектроніки					
Затверд.											



					ДП82.8211.022.001.ФС			
					Фотошаблон	Літ.	Маса	Масштаб
Зм.	Літ.	№ докум.	Підпис	Дата		К		500:1
Розроб.		Лищенко						
Перевір.		Королевич						
Т.конт.						Аркуш	З	Аркушів
					фотолітографія №3	5		
Н.конт.						НТУУ "КПІ", кафедра мікроелектроніки		
Затверд.								



					ДП82.8211.022.001.ФШ			
					Фотошаблон	Літ.	Маса	Масштаб
Зм.	Літ.	№ докум.	Підпис	Дата		К		500:1
Розроб.		Лищенко						
Перевір.		Королевич						
Т.конт.					Аркуш 4 Аркушів 5			
					фотолітографія №4	НТУУ "КПІ", кафедра мікроелектроніки		
Н.конт.								
Затверд.								



					ДП82.8211.022.001.ФШ						
					Фотошаблон	Літ.		Маса		Масштаб	
Зм.	Літ.	№ докум.	Підпис	Дата		К				500:1	
Розроб.		Лищенко									
Перевір.		Королевич									
Т.конт.						Аркуш		5	Аркушів		5
					фотолітографія №5	НТУУ "КПІ", кафедра мікроелектроніки					
Н.конт.											
Затверд.											